

詞彙表

於本文件內，除文義另有所指，本文件內與本公司及其業務相關的若干詞彙的解釋及釋義具有以下涵義。該等詞彙及其涵義未必總是與其行業標準涵義或用法相一致。

「ADAS」	指	先進的駕駛輔助系統，指為提升安全性及駕駛體驗而開發的電子系統，從而實現自動化、自適應和改善車輛系統
「ADC」	指	模數轉換器，一種用於將連續模擬信號轉換為離散數字信號的裝置
「AEC-Q」	指	由美國汽車電子委員會制定的標準
「BCD」	指	雙極型-CMOS-DMOS，為半導體的關鍵工藝技術。其為一類硅工藝，其中每種工藝均將三種不同工藝技術的優勢集成於單一芯片之上：雙極型用於精確模擬功能，CMOS用於數字設計，而DMOS（雙擴散金屬氧化物半導體）則用於功率及高壓元件
「BMS」	指	電池管理系統
「複合年均增長率」	指	複合年均增長率
「CMOS」	指	互補金屬氧化物半導體
「CPU」	指	中央處理器，一種通用處理器，負責獲取、解碼並執行程式指令，協調計算機系統中幾乎所有的計算任務
「DC」	指	直流電
「DFN」	指	雙扁平無引線封裝，一種傳統的功率半導體封裝形式
「EMI」	指	電磁干擾，一種由外部源產生並會影響電路的干擾
「EV」	指	電動汽車

詞彙表

「fab-lite」	指	一種公司專注於設計並具備部分自主製造能力(含晶圓製造或封裝測試)的商業模式
「FOM」	指	品質因數，一種用於評估和比較設備、系統或方法性能的量化指標。其為一種度量標準，有助於評估其相對於其他替代方案的性能
「FRD功率芯片」	指	一種快速恢復二極管器件，用作整流器將交流電轉換為直流電
「氮化鎵」	指	氮化鎵，為一種第三代寬帶隙半導體材料。氮化鎵的優點包括寬帶隙、高飽和漂移速度及高臨界擊穿電場，使其成為大功率、高溫及高頻應用的理想選擇
「GPU」	指	圖形處理器，一種專門設計的電子電路，用於快速處理及變更內存數據，以加速圖像製作
「IC」或「集成電路」	指	集成電路，一種小型單元或封裝，以單一不可分割的結構(如芯片)製成，在電氣上等效於由許多獨立元件組成的傳統電路
「IDM」	指	集成器件製造商，負責設計、製造、封裝、測試及後續銷售成品的公司
「IGBT」	指	絕緣柵雙極晶體管，一種結合了MOSFET的高效能、開關速度快和雙極型晶體管的高電流、低飽和電壓的晶體管
「IoT」	指	物聯網，由通過互聯網相互通信及交換數據的互聯設備組成的網絡
「ISO」	指	國際標準化組織

詞彙表

「ISO 14001」	指	環境管理體系－要求及使用指南，由ISO發佈的環境管理體系標準
「ISO 45001」	指	職業健康與安全管理體系－要求及使用指南，為職業健康與安全管理體系的國際標準
「ISO 9001」	指	質量管理體系－要求，由ISO制定的國際質量管理體系標準
「LDO」	指	低壓差穩壓器，可為車內各種電子系統提供穩定電壓的裝置，用於將汽車電池的波動電壓轉換為敏感電子元件所需的穩定、較低的電壓
「MEMS」	指	微機電系統，整合機械與電子元件的微型裝置
「MOS」或「MOSFET」	指	金屬氧化物半導體場效應晶體管，一種用於放大或開關電子信號的晶體管
「OEM」	指	原始設備製造，按客戶的規格製造產品，供該客戶以客戶的品牌或第三方品牌銷售
「導通電阻」	指	MOSFET導通時漏極與源極之間的電阻值。其通過評估特定條件下漏極到源極的通態壓降進行測量。該值越小，功率損耗越低
「PCB」	指	印刷電路板，一塊具有連接各種元件的電子電路的板子
「Planar MOSFET」	指	一種結構簡單，柵極電極位於晶圓表面，並由一層薄薄的氧化層分隔的MOSFET

詞彙表

「RoHS」	指	歐盟的限制有害物質指令，該指令限制於電子及電氣設備中使用若干有害物質
「Rsp」	指	比導通電阻，用於表示MOSFET導通時的電阻（按有源區歸一化）的關鍵參數。Rsp會影響導通損耗及整體效率，Rsp值越小，功率半導體器件性能越佳
「研發」	指	研究與開發
「SGT MOSFET」	指	屏蔽柵溝槽MOSFET，一種在硅晶圓上蝕刻深溝槽，並將柵極電極嵌入溝槽內的MOSFET
「碳化硅」	指	碳化硅，一種用於各種電子應用的半導體材料
「SJ MOSFET」	指	超結MOSFET，一種基於超結技術的MOSFET
「SOP」	指	小外形封裝，一種傳統的功率半導體封裝形式
「一級供應商」	指	汽車系統集成商，直接向OEM供應組裝元件或系統的公司。一級供應商需在車輛設計與開發階段與OEM密切合作，確保其元件集成至最終產品中
「Trench MOSFET」	指	一種MOSFET，具有垂直結構，其中柵極電極嵌入溝槽內，此結構可實現高元胞密度以降低導通損耗
「VCE (sat)」	指	雙極性結型晶體管中的集電極-發射極飽和電壓
「VDMOS」	指	垂直雙擴散金屬氧化物半導體，一種功率MOSFET，特別適用於具有垂直電流流動的高電流、高電壓應用

詞彙表

「V _{th} 」	指	MOSFET源極與漏極之間形成導電通路所需的最低柵源電壓
「晶圓」	指	半導體材料薄片（如晶體硅），在製造過程中用於製作集成電路或分立器件
「WLCSP」	指	晶圓級芯片尺寸封裝，指在晶圓級封裝集成電路的技術，有別於將晶圓切割成單一單元後再進行封裝的傳統工序